

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公開番号】特開2010-56423(P2010-56423A)

【公開日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【年通号数】公開・登録公報2010-010

【出願番号】特願2008-221899(P2008-221899)

【国際特許分類】

H 01 L 33/36 (2010.01)

H 01 L 33/32 (2010.01)

H 01 S 5/042 (2006.01)

H 01 L 21/28 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/00 E

H 01 L 33/00 C

H 01 S 5/042 6 1 2

H 01 L 21/28 3 0 1 R

H 01 L 21/28 3 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月29日(2011.8.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

A<sub>1-x</sub>Ga<sub>y</sub>In<sub>1-x-y</sub>N(0≤x≤1, 0≤y≤1,かつ0≤x+y≤1)の一般式で表される半導体層と接触し、Agを主成分としPd、Cu及びGeが添加されているAg合金層を含む半導体発光素子用電極。

【請求項2】

前記Ag合金層のPd及びCuの濃度が3質量%以下である請求項1に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項3】

前記Ag合金層のGeの濃度が1質量%以下である請求項2に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項4】

前記Ag合金層は、525以下で熱処理が施されている請求項3に記載の半導体発光素子用電極。

【請求項5】

A<sub>1-x</sub>Ga<sub>y</sub>In<sub>1-x-y</sub>N(0≤x≤1, 0≤y≤1,かつ0≤x+y≤1)の一般式で表される半導体層と、

請求項4に記載の半導体発光素子用電極と、を備えた半導体発光素子。

【請求項6】

前記半導体層は、サファイア基板上に形成され、

前記半導体発光素子用電極は、前記半導体層における前記サファイア基板と反対側に形成される請求項5に記載の半導体発光素子。